

玻尔三大假设 { 量子化定态假设
量子化跃迁频率法则
角动量量子化假设.

n : 主量子数

l : 角量子数 $(0, 1, \dots, n-1)$ 角动量 $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar$

m_l : 磁量子数 $(0, \pm 1, \dots, \pm l)$

m_s : 自旋磁量子数 $(\pm \frac{1}{2})$

$$W_{\text{电场}} = \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV \quad W_{\text{磁场}} = \int_V \frac{B^2}{2\mu_0} dV$$

例 9.1 有两块面积较大的导体薄板平行放置, 它们的面积均为 S , 距离为 d , 见图 9-5. 若给 A 板电荷量 Q_A , B 板电荷量 Q_B , (1) 求导体板四个表面的电荷分布、空间的电场强度分布及两板之间的电势差; (2) 若将 B 板接地, 再求电荷分布、电场强度分布及两板的电势差.

解 (1) 不考虑边缘效应, 静电平衡时电荷将分布在导体板的表面上形成四个均匀带电平面, 设电荷面密度分别为 $\sigma_1, \sigma_2, \sigma_3, \sigma_4$, 由电荷守恒定律可知

$$\sigma_1 + \sigma_2 = \frac{Q_A}{S} \quad (1)$$

$$\sigma_3 + \sigma_4 = \frac{Q_B}{S} \quad (2)$$

由静电平衡条件, 导体板内的 A 点和 B 点的电场强度应为零. 先分析 A 点的电场强度, A 点的电场强度是四个均匀带电平面电场强度叠加而来, 以向右为正, 则 σ_1 在 A 点的电场强度可记作 $E_1 = \sigma_1 / 2\epsilon_0$, 若 σ_1 为正, 则 E_1 为正即电场强度为向右; 若 σ_1 为负则 E_1 为负即电场强度为向左. σ_2 在 A 点的电场强度可记作 $E_2 = -\sigma_2 / 2\epsilon_0$, 若 σ_2 为正, 则 E_2 为负即电场强度向左; 若 σ_2 为负, 则 E_2 为正即电场强度向右. 依次类推, A 点的合电场强度可表示为 $\frac{1}{2\epsilon_0}(\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4)$,

故有

$$\frac{1}{2\epsilon_0}(\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4) = 0 \quad (3)$$

同理, B 点电场强度为

$$\frac{1}{2\epsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 - \sigma_4) = 0 \quad (4)$$

联立以上四式可得

$$\sigma_1 = \sigma_4 = \frac{Q_A + Q_B}{2S}, \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A - Q_B}{2S}$$

两板左边的电场强度:

$$E_I = \frac{1}{2\epsilon_0}(-\sigma_1 - \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4) = -\frac{Q_A + Q_B}{2\epsilon_0 S}$$

两板之间的电场强度:

$$E_{II} = \frac{1}{2\epsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2 - \sigma_3 - \sigma_4) = \frac{Q_A - Q_B}{2\epsilon_0 S}$$

两板右边的电场强度:

$$E_{III} = \frac{1}{2\epsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2 + \sigma_3 + \sigma_4) = \frac{Q_A + Q_B}{2\epsilon_0 S}$$

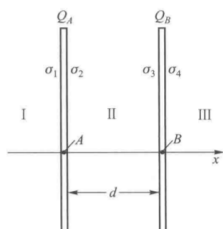


图 9-5 例 9.1 图

(2) 若将 B 板接地, 地面可考虑作一个延伸到无穷远处的导体. 若以无穷远处作为电势零点, 则地面和接地的导体电势均为零. 此时 B 板右表面的电荷量应为零, 即

$$\sigma_4 = 0$$

否则将有电场线由 B 板向右延伸到无穷远处, 按照沿着电场线电势降低的结论, 这意味着 B 板电势与无穷远的电势不同, 这显然不符合上述的等势条件. 此时问题 (1) 中的 (2) 式由

于 B 板和地面交换电荷已经不成立了, 而 (1) 式、(3) 式、(4) 式仍成立. 注意到已有 $\sigma_4 = 0$, 可解得

$$\sigma_1 = \sigma_4 = 0, \quad \sigma_2 = -\sigma_3 = \frac{Q_A}{S}$$

即电荷分布集中于两导体板的内侧, 这是一个典型的平板电容器的电荷分布. 进而可求出三个区域此时的电场强度为

$$E_I = E_{III} = 0, \quad E_{II} = \frac{Q_A}{\epsilon_0 S}$$

两板间的电势差为

$$U_{AB} = E_{II} d = \frac{Q_A}{\epsilon_0 S} d$$